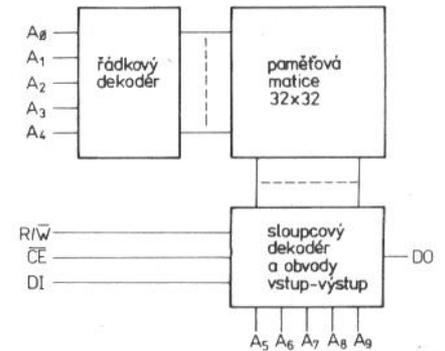


Organizace paměti: 1024 × 1 bit
Paměťová matice: 32 × 32
Funkce zápisu a čtení řízena signálem R/W v bloku dekodéru sloupců
Samostatný vstup a výstup dat D_I , D_O
Výstup dat třístavový, při provozu zápisu dat je aktivní a sleduje stav na vstupu dat.
Obvod se aktivuje signálem \overline{CE} .

FUNKČNÍ BLOKOVÉ ZAPOJENÍ



$A_0 \dots A_9$ adresové vstupy
 D_I datový vstup
 D_O datový výstup
 \overline{CE} vstup uvolnění
 R/\overline{W} vstup čtení/zápis

MEZNÍ HODNOTY:

	min.	max.	
U_I)	-0,5	+7,0	V
P_{tot}		1	W
ϑ_a	0	+70	°C

) Napětí jednotlivých vývodů proti substrátu.
Výstup D_O je v neaktivním stavu.

CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE:

Základní hodnoty statické: $U_{CC} = 5,0 \text{ V} \pm 0,25 \text{ V}$, $\vartheta_a = 0 \dots +70 \text{ °C}$

Příkon ze zdroje U_{CC} $U_I = 5,25 \text{ V}$	I_{CC}	≤ 70	mA
Vstupní svodový proud $U_I = 5,25 \text{ V}$	I_I	≤ 10	μA
Vstupní napětí – úroveň L	U_{IL}	$\leq 0,65$	V
Vstupní napětí – úroveň H	U_{IH}	$\geq 2,2$	V
Svodový proud výstupu v neaktivním stavu $U_O = 4,0 \text{ V}$ $U_O = 0,45 \text{ V}$	I_O $-I_O$	≤ 10 ≤ 100	μA μA
Výstupní napětí – úroveň L $I_{OL} = 1,9 \text{ mA}$	U_{OL}	$\leq 0,45$	V
Výstupní napětí – úroveň H $-I_{OH} = 100 \mu\text{A}$	U_{OH}	$\geq 2,2$	V
Kapacita vstupů $U_I = 5 \text{ V}$, $f = 1 \text{ MHz}$	C_I	≤ 5	pF

Základní hodnoty dynamické: $U_{CC} = +5 \text{ V}$, $\vartheta_a = +25 \text{ °C}$,
zátěž jedno hradlo TTL + 100 pF

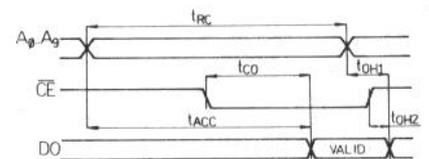
CYKLUS ČTENÍ:

	MHB2102	MHB2102/2	
t_{RC}	≤ 1000	≤ 650	ns
t_{ACC}	≤ 1000	≤ 650	ns
t_{CO}	≤ 500	≤ 400	ns
t_{OH1}	≤ 50	≤ 50	ns
t_{OH2}	≥ 0	≥ 0	ns

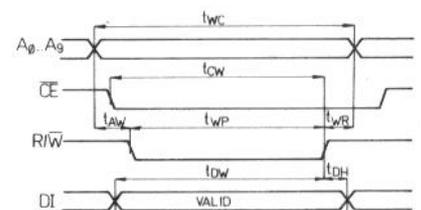
CYKLUS ZÁPIS:

	MHB2102	MHB2102/2	
t_{WC}	≤ 1000	≤ 650	ns
t_{AW}	≤ 200	≤ 200	ns
t_{WP}	≤ 750	≤ 400	ns
t_{WR}	≤ 50	≤ 50	ns
t_{DW}	≤ 800	≤ 450	ns
t_{DH}	≤ 100	≤ 100	ns
t_{CW}	≤ 900	≤ 550	ns

CYKLUS ČTENÍ



CYKLUS ZÁPIS



Impulsní časové průběhy

Typ	Druh	Pouzdro
MHB1902 MHB1902C	Statická paměť CMOS RAM 1024 × 1 bit, organizace paměťové matice 64 řádků po 16 buňkách, vstup a výstup dat je oddělen, vstup třístavový hradlovaný signálem CE. Provoz pro uchování informace vyžaduje napájecí napětí min. 2,5 V. Typ MHB1902C je v keramickém pouzdrů.	IO-18 IO-18/C
MHB2102 MHB2102/2	Statická paměť NMOS RAM 1024 × 1 bit, organizace paměťové matice 32 × 32, vstup a výstup dat je oddělen, výstup třístavový aktivovaný signálem CE.	IO-14A
MHB2114	Statická paměť NMOS RAM 1024 × 4 bity s polykrystalickým hradlem, organizace paměťové matice 64 × 16, vstup a výstup dat je společný, výstup třístavový. Systém obsahuje vnitřní blok generátoru předpětí substrátu, pracujícího na principu nábojové pumpy (Charge Pump), který je připraven k provozu asi 500 μs po připojení napájecího napětí U _{CC} .	IO-18/1
MHB2500 řada	Statické pevné paměti ROM 2560 bitů, vyrobené technologií MNOS na křemikové podložce typu N s tranzistory s kanálem P; mohou pracovat s organizací 256 slov po 10 bitech nebo 512 slov po 5 bitech. Výstupy třístavové, hradlované signálem CS. Organizace, obsah paměti a nastavení signálů CS se vkládají během výroby přepojovací maskou.	IO-15/1
MHB2501 MHB2501A	Generátor alfanumerických znaků v latinské abecedě; kód znaků ASCII odpovídá ČSN 36 8802, RVHP RS 2175-69. Organizace paměti 512 × 5, matice znaku 5 × 7.	
MHB2502 MHB2502A	Generátor alfanumerických znaků v ruské abecedě; kód znaků odpovídá normě RVHP RS 2175-69. Organizace paměti 512 × 5, matice znaku 5 × 8.	
MHB2503	Převodník sedmibitového kódu ISO/7 na dálkopisný kód CCIT2 nebo CCIT2 na ISO/7. Organizace 256 × 10.	
MHB4116 MHB4116C	Dynamická paměť NMOS RAM 16 384 × 1 bit s paměťovou maticí rozdělenou na dvě symetrické části po 64 řádcích a 128 sloupcích. Paměťová buňka jednotranzistorová s paměťovou kapacitou. Paměť vyžaduje obnovení informace vždy po 2 ms činnosti a to 128 cykly čtení nebo prázdnými cykly. Výstup třístavový.	IO-14A IO-18/C
MHB8608	Statická paměť NMOS PROM 1024 × 8 bitů naprogramovaná výrobcem. Vstupy a výstupy jsou plně slučitelné s obvody TTL. Výstupy třístavové, aktivují se signálem pro výběr obvodu CS.	IO-15/1
MHB8708C	Programovatelná paměť NMOS EPROM 1024 × 8 bitů s možností mazání obsahu paměti ultrafialovým světlem s vlnovou délkou max. 0,4 μm. Dávka energie pro mazání min. 15 Wscm ² při zdroji záření 0,2537 μm. Při provozu čtení je funkce obvodu plně statická. Vstupy a výstupy slučitelné s obvody TTL. Výstupy třístavové, aktivují se signálem CS.	IO-15/2

